

2SB554

シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

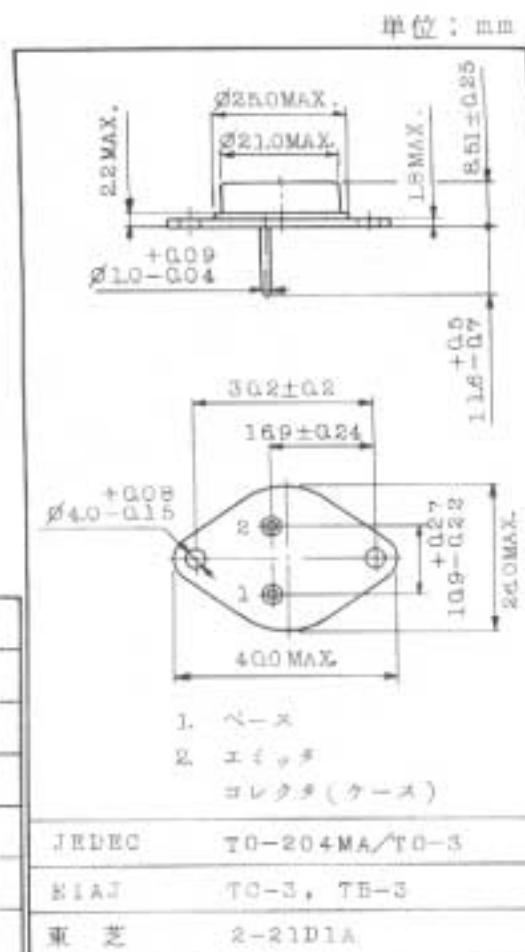
電力増幅用

特長

- コレクタ損失が大きい。: $P_C = 150W$
- 高耐圧です。: $V_{CEO} = -180V$
- 2SD424 とコンプリメンタリになります。
- 100W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-15	A
ベース電流	I_B	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	150	W
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはA073を適用

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A, I_E = 0$	-180	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE} (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	40	—	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10A, I_E = -1A$	—	—	-3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -10A$	—	—	-2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	450	—	pF

注: h_{FE} 分類 R: 40~80, O: 70~140